

Speicherdrosseln
für Frequenzen bis 300 kHz
8 ... 55 A
0,01 ... 0,6 mH

Baureihe CHI 210
Type CHI 213 A/..
Type CHI 213 H/..

Anwendungen:

In getakteten Netzteilen mit hohen Taktfrequenzen, überall, wo hohe Strombelastung bei kleinen Verlusten gefordert wird.



Nennspannung 250 V~	Betriebstemperatur -40 °C...+125 °C
Prüfspannung/Test voltage/Tension d'essai U _p = 2,5 kV/50 Hz/2 sec. (Wicklung/Alu-Becher)	Geprüft nach EN 138000
Nenninduktivität +20% -20% bei 10 kHz	Bauform vergossen im Alu-Becher

Vorteile:

- Hohe Sättigungsinduktion
- Hohes Speichervermögen
- Hohe Taktfrequenz
- Betriebstemperatur max. 125 °C
- Geringe Verluste
- Minimale Streuinduktivität
- Minimales magnetisches Streufeld
- Kompakte Bauform im EMV-günstigen Alu-Becher
- Nach UL 94 V-0

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

Brühler Strasse 100
D-42657 Solingen
Tel. 0049-(0) 2 12-88 04-0
Fax 0049-(0) 2 12-88 04-188
www.reo.de
email: main@reo.de

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

Setzermann Division
Schuldhöfzinger Weg 7
D-84347 Pfarrkirchen
Tel. 0049-(0) 85 61-98 86-0
Fax 0049-(0) 85 61-52 10
www.reo.de
email: setzermann@reo.de

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

IBK Division
Holzhausener Strasse 52
D-16866 Kyritz
Tel. 0049-(0) 3 39 71-4 85-0
Fax 0049-(0) 3 39 71-4 85-88
www.reo.de
email: ibk@reo.de

Technische Daten

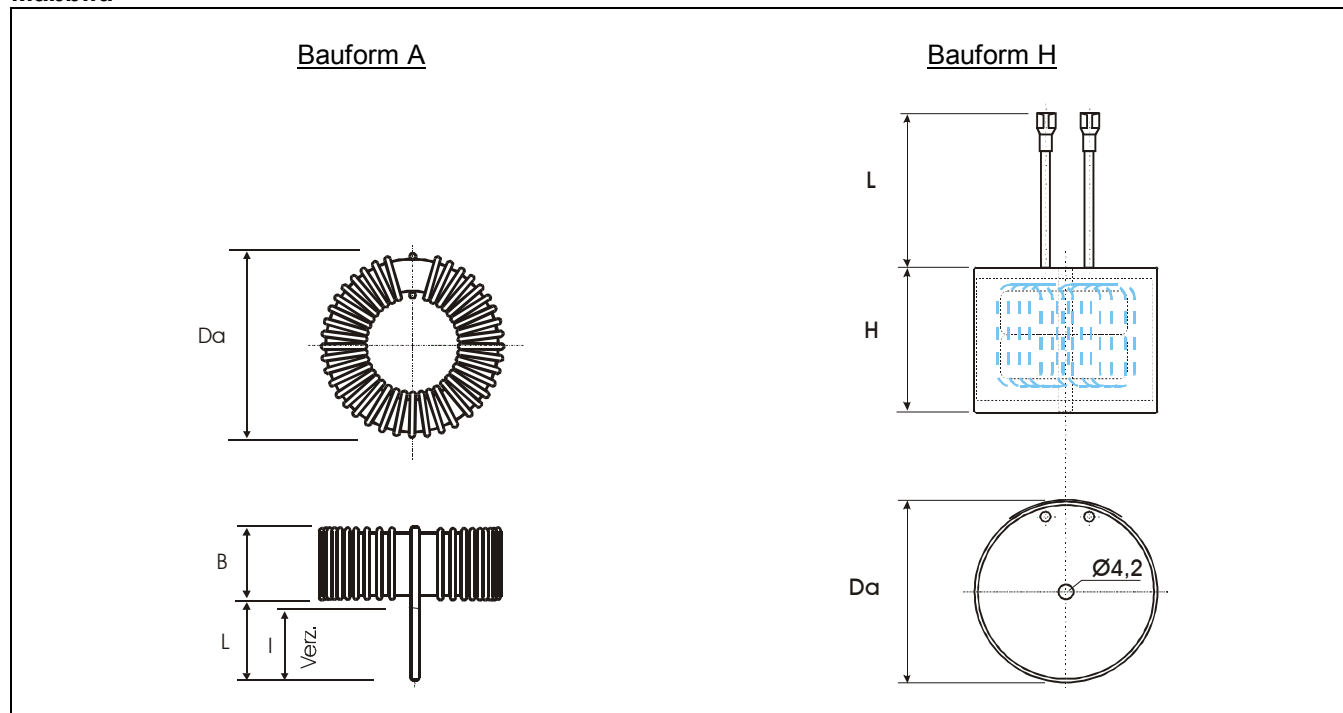
Type	Bauform	BV.-Nr.	Bauform	BV.-Nr.	Nenninduktivität L_N (mH)	Nennstrom I_N (A)	Gleichstromwiderstand R_{CU} (m Ω)
CHI 213 /8/0,6	A	942910	H	942790	0,6	8	110
CHI 213 /10/0,4	A	942911	H	942791	0,4	10	75
CHI 213 /12/0,335	A	942912	H	942792	0,335	12	35
CHI 213 /16/0,15	A	942960	H	942793	0,15	16	32
CHI 213 /20/0,085	A	942961	H	942794	0,085	20	28
CHI 213 /25/0,055	A	942962	H	942795	0,055	25	17
CHI 213 /35/0,03	A	942963	H	942796	0,03	35	10
CHI 213 /55/0,01	A	942964	H	942797	0,01	55	3


Frequenz bis 300 kHz

Frequency up to 300 kHz

Fréquence jusqu'à 300 kHz

Maßbild

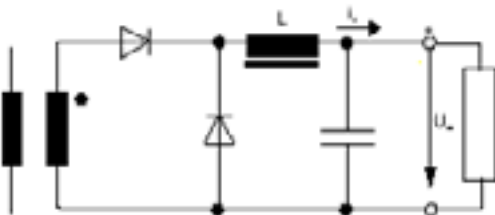


Type	BV-Nr.	Da [mm]	H [mm]	L [mm]	Schaltung
CHI 213 H/8/0,6	942790	50	40	200	
CHI 213 H/10/0,4	942791				
CHI 213 H/12/0,335	942792				
CHI 213 H/16/0,15	942793				
CHI 213 H/20/0,085	942794		50		
CHI 213 H/25/0,055	942795				
CHI 213 H/35/0,03	942796				
CHI 213 H/55/0,01	942797				
CHI 213 A/8/0,6	942910	46	30	20	
CHI 213 A/10/0,4	942911				
CHI 213 A/12/0,335	942912				
CHI 213 A/16/0,15	942913				
CHI 213 A/20/0,085	942914		35		
CHI 213 A/25/0,055	942915				
CHI 213 A/35/0,03	942916				
CHI 213 A/55/0,01	942917				

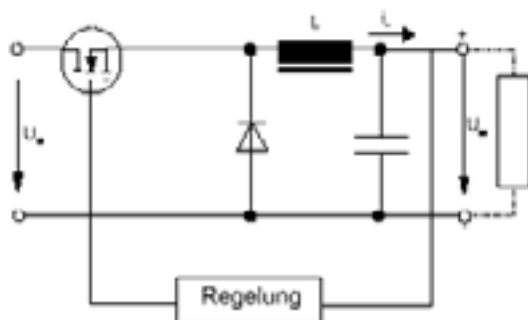
Speicher- und Siebdrosseln

Grundlagen

In Schaltnetzteilen, die nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeiten, sowie in getakteten Längsreglern, werden lineare Speicherdrosseln eingesetzt. Deren Aufgabe ist es, den pulsierenden Gleichstrom zu glätten, indem sie Energie während der Stromflußzeit speichern und in den Pausen den Stromfluß im Lastkreis aufrecht erhalten. Erforderlich sind Induktivitäten mit hoher Gleichstromvorbelastbarkeit. Speicherdrosseln in modernen Stromversorgungen müssen daher hohen Anforderungen gerecht werden, wie beispielsweise hohe Speicherenergie in kleinem Bauvolumen und geringe Verluste bei hohen Taktfrequenzen. Ferner wird ein kostengünstiger Aufbau gefordert.



Speicherdrossel im Ausgangskreis eines Durchflußwandlers



Speicherdrossel L in einem Schaltregler

Gleichstromvorbelastung

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den typischen normierten Verlauf der Induktivität L über der Gleichstromvorbelastung I bei Raumtemperatur.

